

ETHOS

高性能FIB-SEM複合装置

High-Performance Composite FIB-SEM System

高輝度冷陰極電界放出型電子銃と電磁界重置型複合対物レンズを搭載 High-intensity CFE source and magnetic/electrostatic compound lens

SEMカラム内に複数の検出器を搭載 SEM column fitted with multi detectors

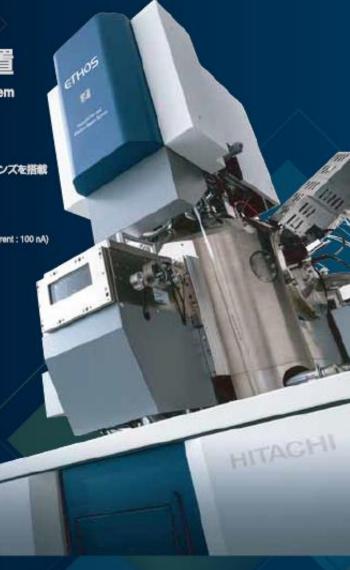
高電流密度FIBによる高速加工(最大ビーム電流:100 nA) Rapid processing due to FIB with high current density (Max. ion beam current : 100 nA)

大容量試料室と複数のチップ試料が搭載できる 155 mm高耐振ステージ

High-volume sample chamber for varied applications also fitted with stage offering high stability

マイクロサンブリング**やトリブルビーム*システム*による 高品位TEM試料作製

High-grade TEM sample preparation possible with Micro Sampling*and Triple Beam system*.



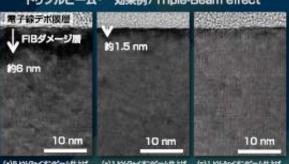
観察例/Observation



3D NAND デバイス 断面SEM像

3D NAND device cross-section SEM image

トリブルビーム® 効果例/Triple-Beam effect



(a)6 KV-Ga-C#72C-Lift Elf (b) 4 W-Gallium ion milling

試料(GaN): <1-100>電子級入射方位における高分解館TEM像 Gaイオンビーム仕上げでは加工ダメージ階(矢印)が観察されています Arイオンビーム仕上げは試料表面まで結晶性が保持されています

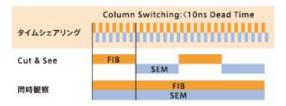
High-resolution TEM images of GaN crystal on the <1-100> axial illumination 1 kV Argon ion milling preserve crystallinity to the surface

Hitachi Ethos NX5000



タイムシェアリングモード

ガリウムによる加工中にリアルタイムでシーンに分けたSEMによる観察が可能

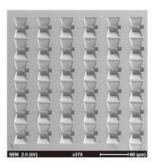


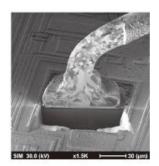
- ■最適な位置での終点検知を優先した タイムシェアリングモード
- ■高分解能なSEM観察を目的したCut&Seeモード
- ■FIBによる加工時間を優先した同時観察モード



高性能FIBカラム

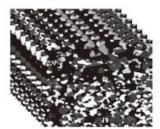
高電液密度FIBにより高速加工を実現し、 大面積領域の加工や数個所の プログラム加工が可能







Cut & Seeによる三次元再構築イメージング*3

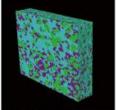


図体限化物形燃料電池の燃料機(NI-YSZ) 試料ご提供:東京大学 生産技術研究所 楽園 直般 教授

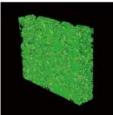
FOV:20 μm Cut & See:200枚 ビッチ:20 nm SEM加速電圧:1.5 kV

Supported by Image Pro Premier3D

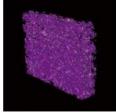




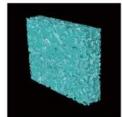
3D再構築(Ni-Zr- Void)



3D再構築(Ni:ニッケル)



3D再構築(Zr:ジルコニウム)



3D再構築(空隙:樹脂埋め)

*3:3次元再模築イメージングには専用ソフトが必要になります。

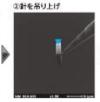
Hitachi Ethos NX5000

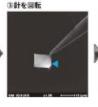


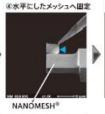
ACE技術を活用したTEM試料作製

■マイクロサンプリング[®]姿勢制御によるカーテニング効果の抑制



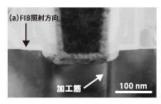


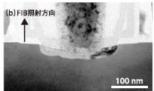






複雑な構造を持つ半導体デバイスや空隙などを含む複合材料において、様々な角度からイオンビームを照射できるように 姿勢制御することで、加工スジをキャンセルします。





コンタクトプラグ下部のTEM観察結果

a:姿勢制御無 b:180°姿勢制御 観察装置:300 kV FE-TEM

■FIB加工ダメージを抑制した良質なTEM試料作製

低加速アルゴンイオンビームを使用することによりガリウムイオンビームによるダメージ除去が可能

(a) 2 kV FIRMT

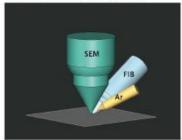




AlzO1 単結晶の[1¹0]電子線入射方位における高分解能TEM像

2 kV FIB加工においては、ガリウムイオン規制によるFIBダメージ(赤矢印) が観察 されています(図a)。一方、1 kV アルゴンイオンミリングにおいては、FIBダメージ層 は除去され、結晶格子像が明瞭に観察できています。

トリブルビーム[®] システム(アルゴン/キセノン)



極薄試料の作製には、平坦化でかつダメージの少ない加工方法を用いる必要があります。 ETHOSでは試料の姿勢制御と低加速アルゴンイオンビーム加工とを組み合わせたACE技術 により、良質なTEM試料を作製します。 ACE: Anti Curtaining Effect